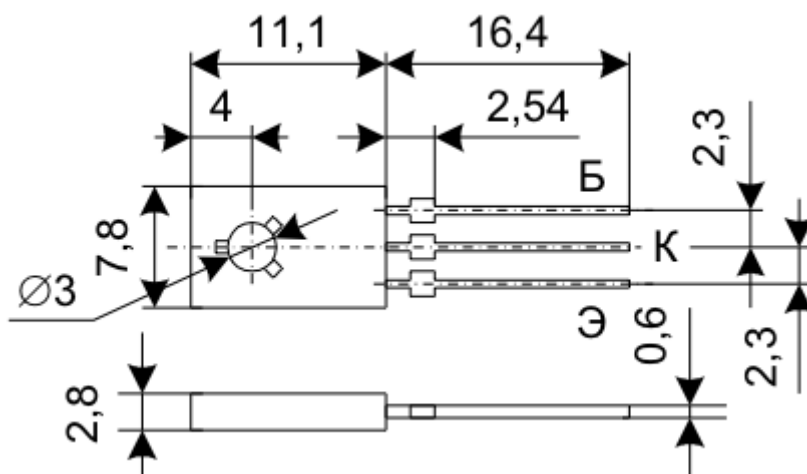


КТ639Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, усилителях мощности, видеоусилителях, автомобильных электронных устройствах, импульсных и переключающих устройствах, в оконечных устройствах ЭВМ.

Транзисторы выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.



Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов не более 0,7 г.

Тип корпуса: КТ-27-2.

Технические условия: аА0.336.267 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора КТ639Б:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ}=2$ В, $I_{к}=150$ мА: 63... 160;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб}=5$ В, $I_{к}=30$ мА: не менее 80;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 30$ В: не более 100 нА;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В: не более 50 пФ.
- $U_{кб\max}$ - Максимальное постоянное напряжение коллектор-база: 45 В;
- $U_{кэ\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм: 45 В;
- $U_{эб\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 5 В;
- $I_{к\max}$ - Максимально допустимый постоянный (импульсный при $t_{и}=10$ мкс) ток коллектора: 1,5 (2) А;
- $P_{к\max}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 1 Вт;
- $t_{п}$ - Температура р-п перехода: не более 150°C;
- $t_{окр}$ - Температура окружающей среды: -60...+125°C.